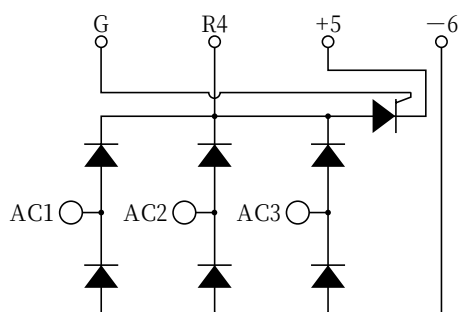
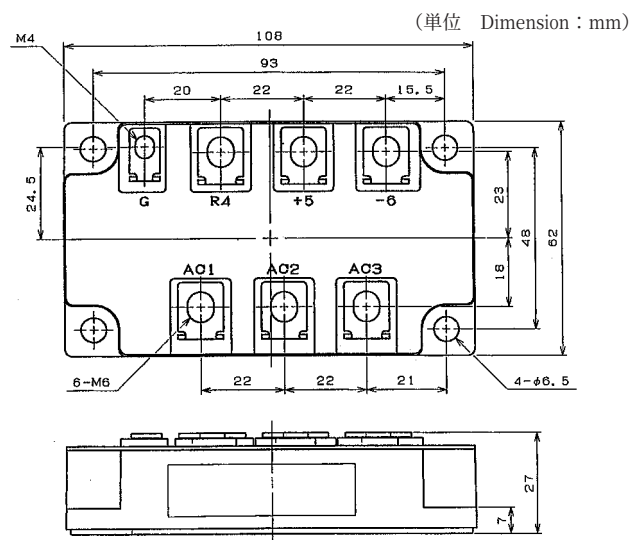


THYRISTOR**150A Avg 800 Volts****PGH1508AM**

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING



総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor

■最大定格 Maximum Ratings

項 目 Parameter		記号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均出力電流 Average Rectified Output Current		I ₀ (AV)	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified	T _c = 102°C(電圧印加なし) Non-Bias	150	A
				T _c = 77°C(電圧印加あり) Bias	150	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}	125~150°Cはサイリスタ部に順・逆電圧印加しない事 T _j >125°C, Can not be Biased for Thyristor.		-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			-40~+125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V _{iso}	端子ーベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.		2000	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5~3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M6	2.5~3.5	N・m
	ゲート端子部 Gate Terminal			M4	1.2~1.6	N・m

■熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケースーフィン間(トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	°C/W

質量 Approximate Weight...約530g

ダイオードブリッジ部 (6素子) Part of Diode Bridge (6dies)

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	PGH1508AM 800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1100	A
電流二乗時間積 I^2 Squared t	I^2t	2 ~ 10ms	6050	A ² s
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

*1: 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■電気的特性 Electrical Characteristics

項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I_{RM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_{RM}=V_{RRM}$	15	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V_{FM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_{FM}=150\text{A}$	1.20	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部－ケース間 (トータル) Junction to Case, Total	0.14	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

*1: 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部 (1素子) Part of Thyristor (1die)

■最大定格 Maximum Ratings

項 目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PGH1508AM	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	900	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

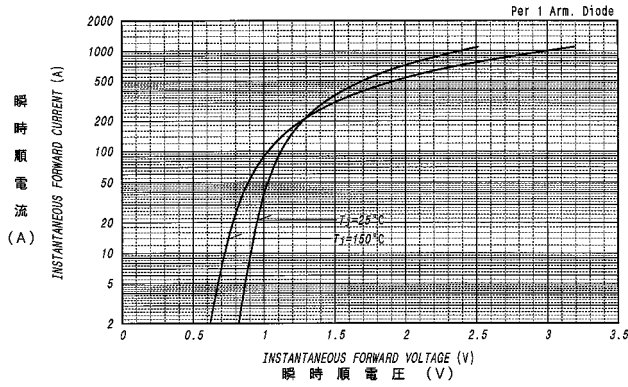
項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I_{TSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	2700	A
電流二乗時間積 $I^2 \text{ Squared } t$	$I^2 t$	2 ~ 10ms	36400	A^2s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D=2/3V_{DRM}$, $I_{TM}=2 \cdot I_O$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$ $I_G=300\text{mA}$, $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$	100	$\text{A}/\mu\text{s}$
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V

■電気的特性 Electrical Characteristics

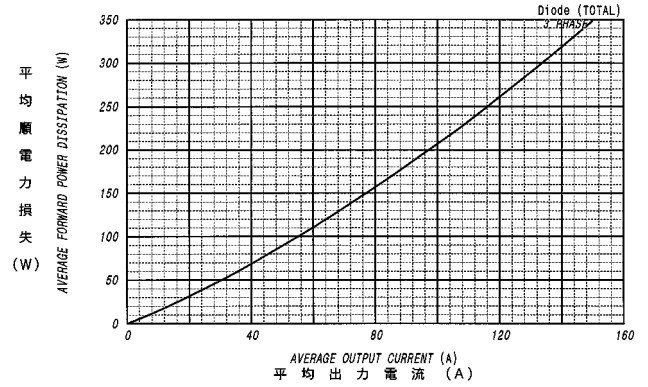
項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_{DM}=V_{DRM}$			20	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_{RM}=V_{RRM}$			20	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V_{TM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_{TM}=150\text{A}$			1.23	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D=6\text{V}$, $I_T=1\text{A}$	$T_j=-40^{\circ}\text{C}$		300	mA
			$T_j=25^{\circ}\text{C}$		150	mA
			$T_j=125^{\circ}\text{C}$		80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D=6\text{V}$, $I_T=1\text{A}$	$T_j=-40^{\circ}\text{C}$		5.0	V
			$T_j=25^{\circ}\text{C}$		3.0	V
			$T_j=125^{\circ}\text{C}$		2.0	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$	500			$\text{V}/\mu\text{s}$
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $I_{TM}=I_O$, $V_D=2/3V_{DRM}$ $dv/dt=20\text{V}/\mu\text{s}$, $V_R=100\text{V}$, $-di/dt=20\text{A}/\mu\text{s}$		150		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$, $I_{TM}=3 \cdot I_O$ $I_G=300\text{mA}$, $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d			2		μs
立上がり時間 Rise Time	t_r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部－ケース間 Junction to Case			0.3	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

■ 定格・特性曲線

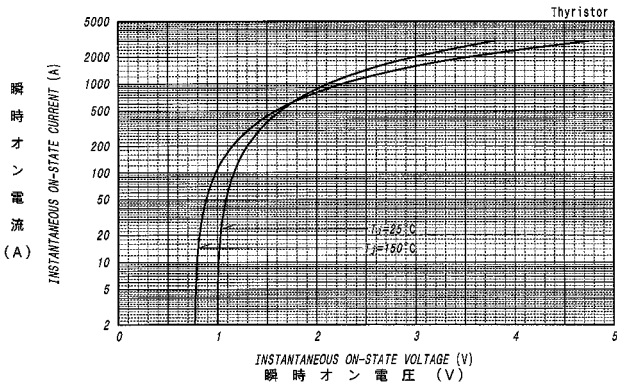
順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



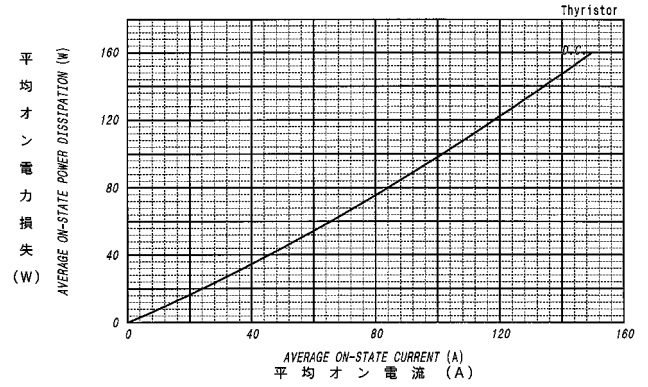
平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



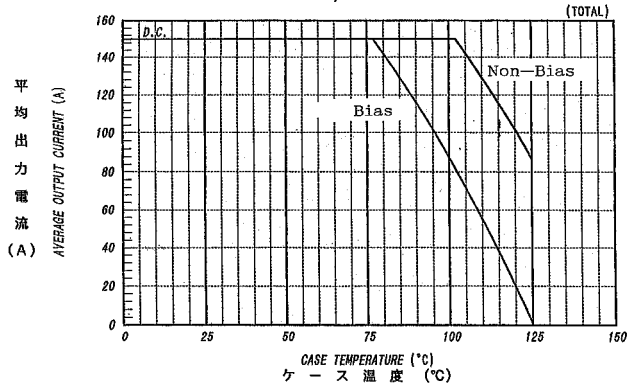
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



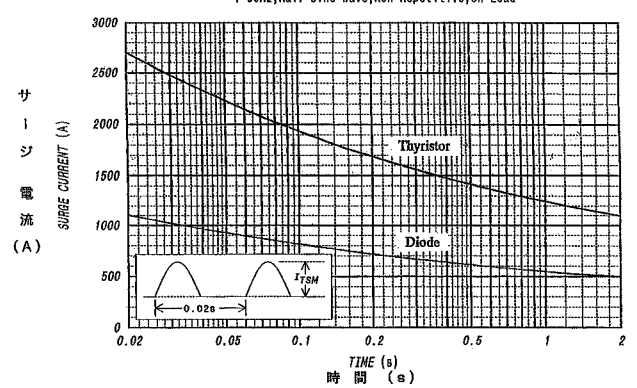
平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



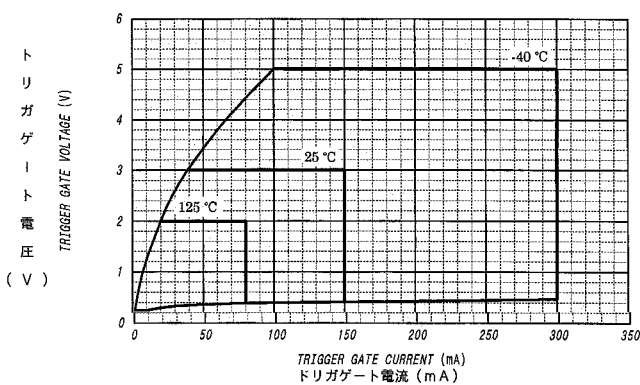
平均出力電流 - ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load



サージ電流定格
SURGE CURRENT RATINGS
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, On Load



ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格
GATE RATINGS

